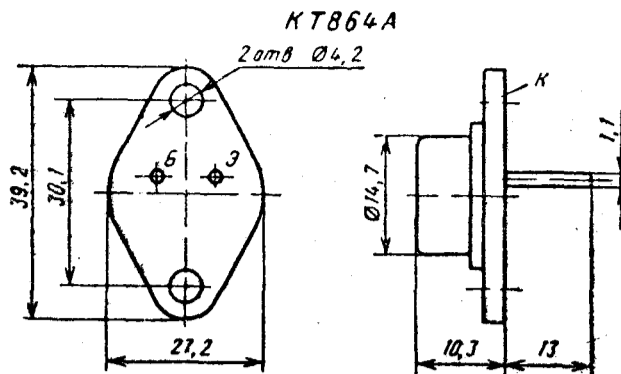


КТ864А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* импульсный. Предназначен для применения в источниках вторичного электропитания, преобразователях, оконечных каскадах усилителей звуковой частоты, стабилизаторах напряжения. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=4$ В, $I_B=2$ А:

$T=+25^\circ\text{C}$	40...200
$T=+125^\circ\text{C}$	40...250
$T=-60^\circ\text{C}$	15...200

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=10$ В, $I_K=0,2$ А, не менее

15 МГц

Граничное напряжение при $I_K=0,05$ А, не менее

160 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=6$ А, $I_B=0,6$ А, не более

2 В
типичное значение 0,7*В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=6$ А, $I_B=0,6$ А, не более

2 В
типичное значение 1* В

Обратный ток коллектора при $U_{КБ}=200$ В, не более:

$T=+25^\circ\text{C}$	0,1 мА
$T=+125^\circ\text{C}$	1 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ}=6$ В, не более

3 мА

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ}=5$ В, не более

300* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ}=0,5$ В, не более

2000* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база при $dU_{КБ}/dt=200$ В/мкс

200 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{сг} \leq 10$ Ом, $dU_{КЭ}/dt=200$ В/мкс

200 В

Постоянное напряжение база — эмиттер

6 В

Постоянный ток коллектора

10 А

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 2$ мс, $Q \geq 2$

15 А

Постоянный ток базы

2 А

Импульсный ток базы при $t_u \leq 1$ мс, $Q \geq 2$

4 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K=-60...+25^\circ\text{C}$:

с теплоотводом ¹	100 Вт
без теплоотвода ²	1,5 Вт

Температура *p-n* перехода

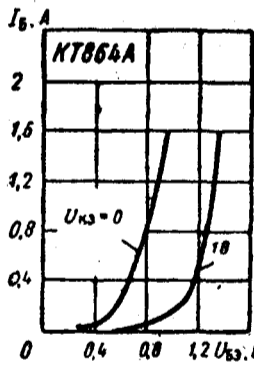
+150 °C

Температура окружающей среды

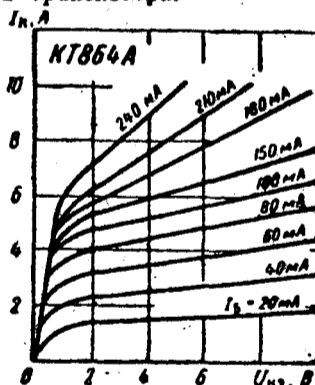
-60 °C... T_K = +125 °C

¹ При $T_K=-25...+125^\circ\text{C}$ $P_{ж, макс}$ снижается линейно до 30 Вт
² При $T_K=-25...+125^\circ\text{C}$ $P_{ж, макс}$ снижается линейно до 0,3 Вт

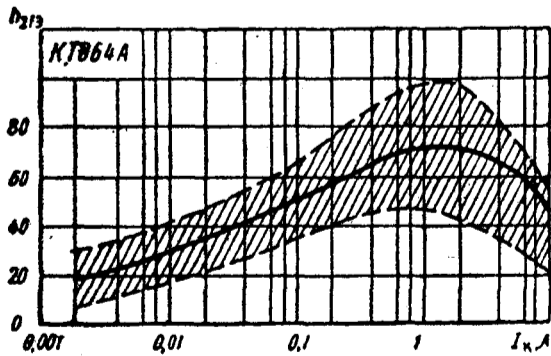
Пайка выводов транзистора допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре припоя +270 °C в течение не более 3 с, время лужения не более 2 с. Допускается не более трех перепаяк выводов транзистора.



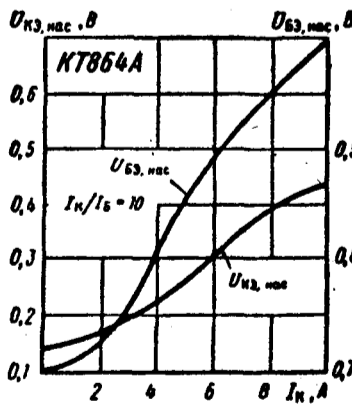
Входные характеристики



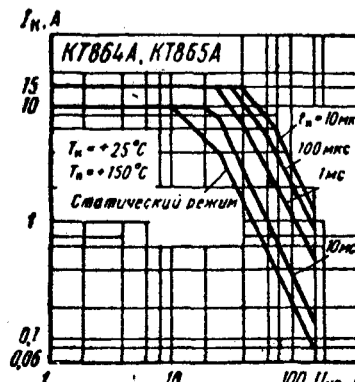
Выходные характеристики



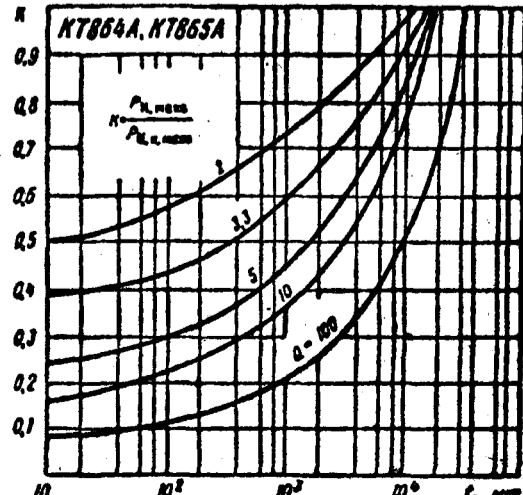
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



Область максимальных режимов



Зависимость коэффициента *K* от длительности импульса